浙江大学

电路与电子技术 实验报告

| 实验名称: | 半导体二极管特性测试 |
|-------|------------|
| 实验人员: | 潘谷雨、杨骐恺 |
| 报告撰写: | 潘谷雨 |
| 学号. | 3220102382 |

实验日期: 2023 年__9__月__25__日

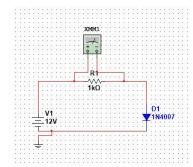
地点: 东三 406

【实验目的】

- 1. 掌握半导体二极管特性测试。
- 2. 学习 MULTISIM 电路仿真软件的使用。
- 3. 进一步熟悉电子仪器的使用。

【实验内容】(测试方案,含仿真与硬件测试两种类型)

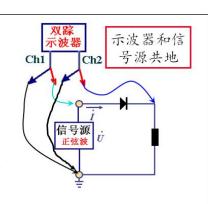
- 一、用万用表粗略判别二极管好坏
- 1. 将数字万用表拨至二极管测试档,取一标有 5. 1V/1W 的稳压二极管,将红表笔接入正极,黑笔接入负极,测量正向导通压降 U1+。
- 2. 调换红黑表笔,测量稳压二极管反向压降 U1-。
- 3. 取 1N4007 二极管, 重复上述实验, 测量正向导通压降 U2+、反向压降 U2-。
- 二、采用逐点测量法测量二极管的 VA 特性
- 1. 将可变稳压源 Us、标有 $1k\Omega/1W$ 的电阻 R、1N4007 二极管 L 串联,将万用表并联在电阻两端。
- 2. 由小到大调节电源电压 Us,用万用表合适量程的直流电压挡测量电阻 R 两端电压 UR,记录数据。



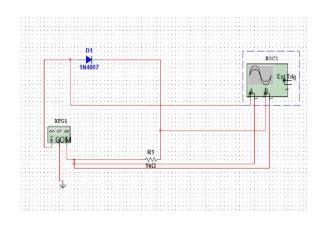
- 3. 计算二极管两端电压 UL = Us-UR,电流 i = UR/R,根据不同电流状态下的二极管电压绘制 1N4007 二极管的 VA 特性曲线。
- 三、采用扫描测量法测量二极管的 VA 特性,并双踪观察信号源与二极管两端电压
- 1. 将信号源、标有 $1k\Omega/1W$ 的电阻 R、1N4007 二极管 L 用导线串联,将双踪示波器接入电路中,CH1 通道测量信号源两端电压 Us,CH2 通道测量电阻两端电压 UR。注意 CH1、

CH2 的黑线均接地。

- 2. 调整信号源参数,使其发出频率 f = 1 kHz、幅值 A = 3V、偏移 0V、对称性 50%、相位 0 的锯齿波。
- 3. 通过示波器的 XY 功能得到 VA 特性曲线,将数据导出,根据不同电流状态下的二极管电压,绘制 1N4007 二极管的 VA 特性曲线。



四、应用 MULTISIM 软件仿真二极管的 VA 特性



- 1. 如图在 MULTISIM 软件上搭建电路,调整信号源函数发生器的参数,使其发出频率 f
- = 1kHz、振幅 Vp = 3V、偏置 0、占空比 50%的锯齿波。
- 2. 通过示波器的 XY 功能得到 UR-Us 图像,导出数据计算得到不同电流状态下的二极管电压,绘制 1N4007 二极管的 VA 特性曲线。

【测试过程与结果】(注明测试设备、原始数据)

一、用万用表粗略判别二极管好坏(测试设备: UT890D+数字万用表, 稳压源: GPD-4303S 直流电源)

稳压二极管(5.1V/1W): 正向导通压降 U1+ = 0.711V。测量反向压降 U1-时超量程。

由于二极管测试档内部电路开路电压仅 3V, 为了验证稳压二极管反向功能是否符合标

准,将该二极管反向接入电路并与标有 1k Ω/1W 的电阻串联,改变稳压直流电源电压 Us,得到以下数据:

Us/V 6. 403 10. 403 13. 401 U1-/V 4. 601 4. 930 5. 027

1N4007 二极管: 正向导通压降 U2+ = 0.574V, 测量反向压降 U2-时超量程。

二、采用逐点测量法测量二极管的 VA 特性(测试设备: UT890D+数字万用表,稳压源: GPD-4303S 直流电源)

方案选择:

- ①由于万用表电流挡误差较大,电压挡误差较小,因此实验时用测量电阻两端电压代 替测电流的方案。
- ②可固定 Us,调节 R,用万用表直接测量不同电流状态下的二极管电压。但是,实验室中电位器不能显示电阻大小,因此必须测量电流。万用表与稳压源的电流测量误差均较大,因此该方案并非最佳。

作为验证二极管的 VA 特性的方案,本组实验仅在正向电压的情况下选取测试点,并在 i-UL 曲线斜率出现较大变化处集中取点。负向电压情况见下组扫描法测 VA 特性实验。

测量过程中,调整稳压源电压时注意方向一致,不可回调,以减小旋钮造成误差。 万用表测前 10 组数据时,采用直流电压 600mV 挡,最后 2 组数据采用直流电压 6V 挡。

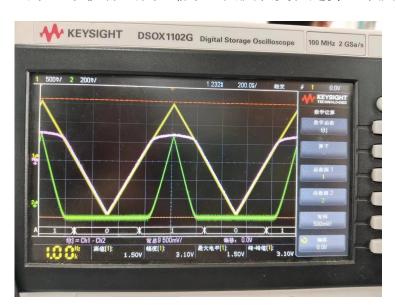
Us/V 0.902 0.103 0.302 0.401 0.501 0.602 0.702 0.802 1.002 1.102 1.202 2.003 UR/V 0.000 0.0015 0.0136 0.05540.1196 0.19470.2762 0.3611 0.5372 0.632 1.410 0.4486 UL/V 0.103 0.301 0.387 0.446 0.482 0.507 0.526 0.541 0.553 0.565 0.570 0.593 0.449 i/mA 0.014 0.276 0.632 0.000 0.002 0.055 0.120 0.195 0.361 0.537 1.410

三、采用扫描测量法测量二极管的 VA 特性,并双踪观察信号源与二极管两端电压(测

试设备: DSOX1102G 示波器, 信号源: DG1022 信号发生器)

示波器可导出各时刻 CH1、CH2 的电压,得到足够多组 Us、UR 的数值。

下图为示波器显示波形图。黄线为 CH1 通道所测信号源两端电压 Us,绿线为 CH2 通道所测电阻两端电压 UR,紫线为示波器通过函数计算 Us-UR 所得二极管两端电压 UL。(注意:图中线经过了上下移动、放大缩小,只反映变化趋势,不反映实际电压。)

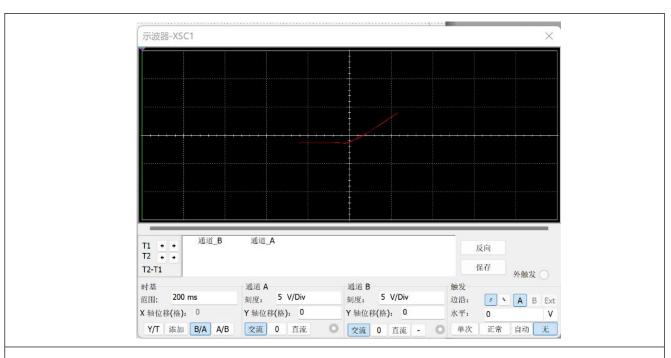


绿线齐平、紫线与黄线重合的时间内,电源电压反向或正向电压较小,二极管处于截止状态。紫线接近齐平的时间内,二极管处于导通状态,UL近似不变,UR近似线性变化;但在电压正向增大的过程中,二极管两端电压仍有微小增大,因此若将CH1(此时为500mV/格)与CH2的刻度(此时为200mV/格)调为一致,屏中显示绿线(UR)斜率小于黄线(Us)。

四、应用 MULTISIM 软件仿真二极管的 VA 特性

软件可导出各时刻 Channel_A、Channel_B 的电压,得到足够多组 Us、UR 的数值。数据处理见结果分析部分。

示波器显示图形(UR-Us)如下:



【结果分析】

一、用万用表粗略判别二极管好坏

稳压二极管 (5.1V/1W):

U1+ = 0.711V,接近硅二极管导通电压 0.7V,判断其正向功能完好。

Us/V 6. 403 10. 403 13. 401 U1-/V 4. 601 4. 930 5. 027

测量反向压降时可见 Us 增加, U1-越来越接近标称电压 5.1V, 反向功能完好。故判断该稳压二极管完好。

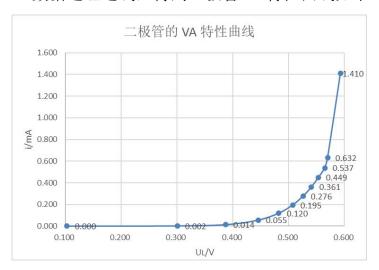
1N4007 二极管:

U2+ = 0.574V。说明书表明 1N4007 二极管在电流 1A 的情况下,正向压降为 1V。由于导通电流为 mA 量级,导通区电流随电压增大而迅速增大,因此 0.574V 合理,判断其正向功能完好。

对于测量反向压降 U2-时超量程,说明反向击穿电压相对较大,判断其反向功能完好。故判断该二极管完好。

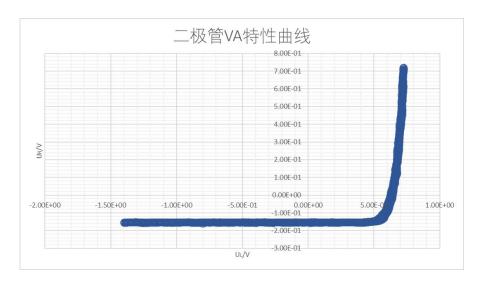
二、采用逐点测量法测量二极管的 VA 特性

利用各组 i-UL 数据逐组连线,得到二极管 VA 特性曲线如下。



当 0<UL<0.301V 时,流过二极管的电流近似于 0,为截止区,二极管可视作不导通。 当 UL>0.301V 时二极管进入导通区:当 UL<0.565V 时,电流随电压增大而增大, 且斜率越来越大;当 UL>0.565V 时斜率极大,极小的△UL 会引起电流巨大的变化,此 时二极管两端电压可近似看作不变。

三、采用扫描测量法测量二极管的 VA 特性,并双踪观察信号源与二极管两端电压 由于 i ~ UR, UL = Us-UR, 所以二极管的 VA 特性曲线 iL-UL 形状与 UR-(Us-UR) 相同。利用导出的多组 Us、UR 数据得到信号源与二极管两端电压关系 UL-Us 曲线如下:



当-1.42V<UL<0.57V时,UR不变,均为约-0.15V,二极管视为截止;当UL>0.57V

时二极管进入导通区,电流随电压增大而增大,且斜率越来越大;当 UL 接近 0.7V 时斜率极大,极小的 \(\Delta\) L 会引起电流巨大的变化,此时二极管两端电压可近似看作不变。

理论上二极管在截止区流过电流应为 0,即电阻两端所测电压 UR 应为 0。以下是实验中示波器导出的 UR 为负数的影响因素:

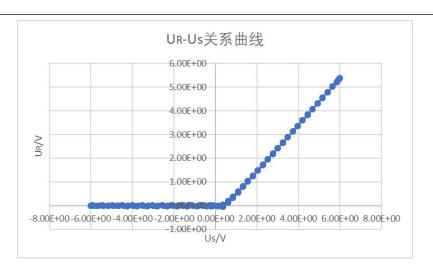
- ①二极管本身的非理想特性。实际的二极管并不完全符合理想二极管模型,存在接触电阻、反向漏电流等非理想情况。接触电阻只可能降低 UR,而不是使其处于反向的稳定数值,而反向漏电流可解释这一现象。
- ②示波器存在校准问题。横轴为 UL,为 Us-UR 算得,因此两校准偏差抵消,但由于纵轴为 UR,校准偏差未抵消,因此实际所绘图线比理想情况下移 1.5V。
- ③示波器存在电压分辨率阈值。示波器电压分辨率阈值在 mV 数量级,截止区 UR 约为-150mV,故其存在一定影响。
- ④示波器存在系统误差。电压探头通常包含一个电阻和并联的电容,但由于实验 频率在 1kHz,相对较低,示波器输入阻抗通常在兆欧姆($M\Omega$)数量级,对结果影响较 小。

综上,二极管的反向漏电流与示波器的校准为主要原因。

四、应用 Multisim 软件仿真二极管的 VA 特性

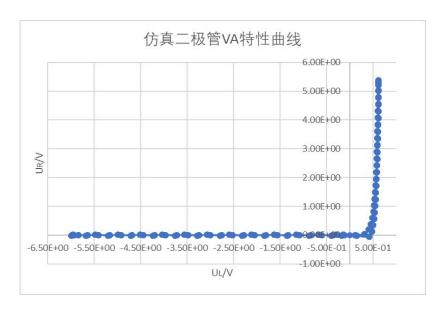
电路图同上, 故数据处理方式同上。

由于在 Multisim 软件示波器显示的 UR-Us 图像中,当 Us 较小或反向时,UR 会出现负数情况,因此用导出的多组 Us、UR 数据重新绘制,得到图像如下:



与测试过程中示波器产生图样进行对比,可见大体趋势不变,属示波器显示与校准问题。

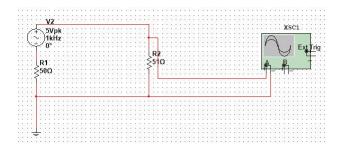
描点得到二极管 VA 特性曲线如下。



当-6.00V<UL<0.50V时,UR均为0,电路中无电流,二极管视为截止;当UL>0.50V时二极管进入导通区,电流随电压增大而增大,且斜率越来越大;当UL接近0.51V时斜率极大,极小的△UL会引起电流巨大的变化,此时二极管两端电压可近似看作不变。

【探究性实验内容】

分压法测量信号源内阻(测试设备: DSOX1102G 示波器, 信号源: DG1022 信号发生器)



- 1. 将标有 $51 \Omega / 1W$ 的电阻 R 接入信号源两端,信号源输出频率 f = 1kHz、幅值 A =
- 5.000Vpp、偏移 0V、相位 0°的正弦波,将示波器并联在电阻两端测其电压 U1。
- 2. 保持信号源输出参数不变,换不同阻值或同一标称的不同电阻,重复实验,记录数据。记信号源内阻为 r。

| R/Ω | 51 | 51 | 10 | 100 | 330 | 510 | |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| U/V | 2.42 | 2.45 | 0.89 | 3.34 | 4.39 | 4.51 | |
| Ur/V | 2.58 | 2.55 | 4.11 | 1.66 | 0.61 | 0.49 | |
| r/Ω | 54.37 | 53.08 | 46.18 | 49.70 | 45.85 | 55.41 | |
| 平均值 | FO 77 | | | | | | |
| r' /Ω | 50. 77 | | | | | | |

结果分析:

通过上述 6 组数据,可算得信号源内阻 r 均值为 50.77 Ω,可算得不确定度

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum (r_i - \bar{r})^2} = 1.7\Omega$$
 ,所以求得信号源内阻为 50.77±1.7 Ω 。

已知信号源 SDG2000X 内部提供 $50\,\Omega$ 的固定串联输出阻抗,可得相对误差 E = $|50.77\,\Omega-50\,\Omega|/50\,\Omega=1.54\%$ 。